

### DL 2605 GROUPE SCR

Six SCR avec réseau RCD de protection aptes à réaliser des redresseurs contrôlés et inverseurs.

Caractéristiques techniques:  
Courant directe moyenne

$$I_{TAV} = 7,6 \text{ A max.}$$

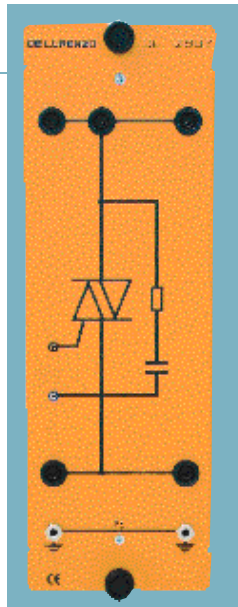
Valeur efficace du courant direct  $I_{TRMS} = 12 \text{ A}$

Tension max. inverse répétitive  $U_{RRM} = 800 \text{ V}$

Courant d'amorçage  $I_{GT} = 15 \text{ mA max.}$

Tension d'amorçage  $U_{GT} = 1,5 \text{ V max.}$

$$I^2t = 72 \text{ A}^2\text{s}$$



### DL 2607 TRIAC

Thyristor bidirectionnel employé pour le contrôle en courant alternatif. Complet de réseau RC d'étouffement.

Caractéristiques techniques:

Valeur efficace du courant direct

$$I_{TRMS} = 8 \text{ A}$$

Courant de crête non répétitive

$$I_{TSM} = 70 \text{ A, } 50 \text{ Hz (77 A, } 60 \text{ Hz)}$$

Tension max. directe répétitive

$$U_{DRM} = 800 \text{ V}$$

Courant d'amorçage

$$I_{GT} = 25 \text{ mA max. (tous les quadrants)}$$

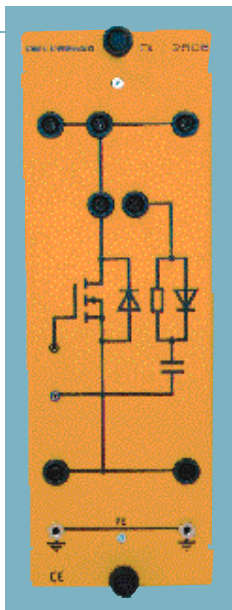
Tension d'amorçage

$$U_{GT} = 2,5 \text{ V max.}$$

Courant de maintien

$$I_H = 25 \text{ mA max.}$$

$$I^2t = 24 \text{ A}^2\text{s}$$



### DL 2608 MOSFET

MOS de puissance à canal N à enrichissement avec diode inversé de protection (FRED, Fast Recovery Epitaxial Diode) employé en interrupteur vite dans les régulateurs à commutation et dans les invertis.

Caractéristiques techniques:

Tension drain-source  $U_{DS} = 400 \text{ V}$

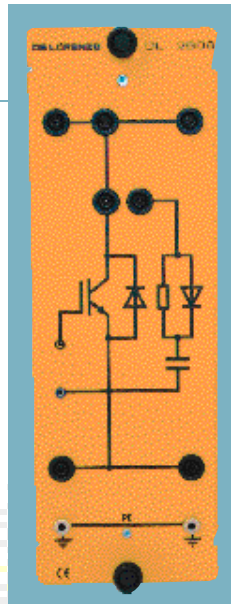
Courant continu de drain

$$I_D = 10 \text{ A}$$

Résistance drain-source dans l'état on

$$R_{DS(on)} = 0,55$$

Tension gate-source  $U_{GS} = \pm 20 \text{ V}$



### DL 2609 IGBT

Transistor bipolaire avec gate isolé (IGBT) à canal N avec diode inversé ultravite de protection employé en interrupteur vite dans les régulateurs à commutation et dans les inverter.

Caractéristiques techniques:

Tension collecteur-émetteur

$$U_{CES} = 600 \text{ V}$$

Courant continu de collecteur

$$I_C = 24 \text{ A à } T_c = 25^\circ\text{C}$$

Tension de saturation

$$U_{CEsat} = 1,8 \text{ V}_{typ} \text{ à } I_C = 15 \text{ A}$$

$$U_{GE} = \pm 20 \text{ V}$$